大電流MOSFET：HSOP8パッケージ

パワーPKG(HSOP8)にて実装時の損失を抑え、大電流を実現！

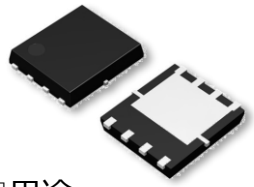
INK0XXXAG1/INJ0XXXAG1

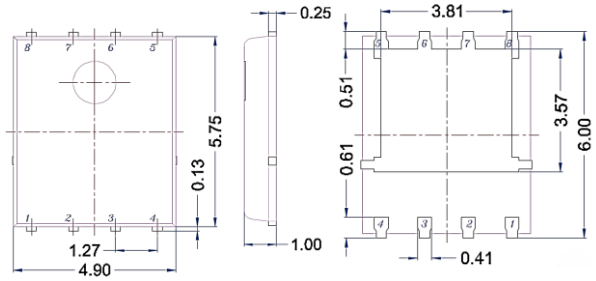
開発中

□概要

当社のMOSFETラインナップに大電流で使用できるパワーPKG(HSOP8)の製品を新たに追加いたしました。
ラインナップにない製品に関しても積極的に開発検討しますので
お気軽にご相談下さい。

□外形図（単位：mm）

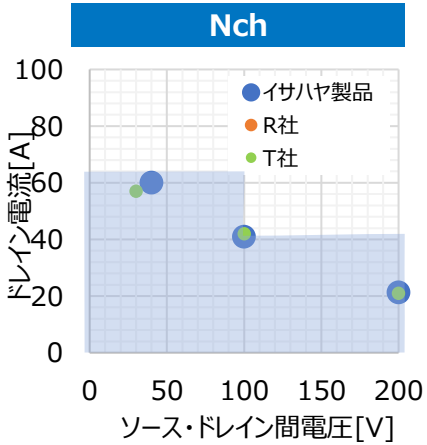


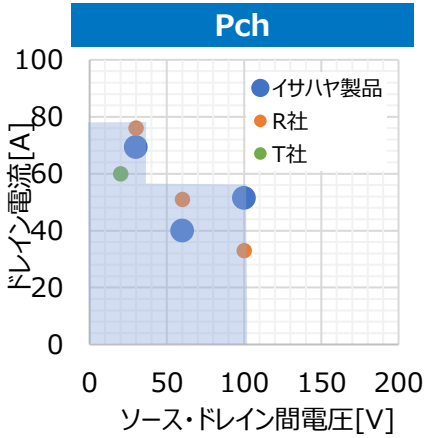


□用途

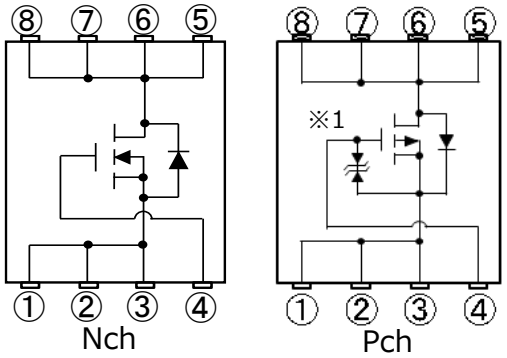
- ●スイッチングレギュレータ
- ●DC/DCコンバータ

□耐圧-電流マップ





□内部等価回路



電極接続
①ソース
②ソース
③ソース
④ゲート
⑤ドレイン
⑥ドレイン
⑦ドレイン
⑧ドレイン

※1 INJ0E22AG1のみ保護DI入り

□製品ラインナップ

製品型名	極性	VDSS [V]	ID[A] @TC=25℃	ID[A] @Ta=25℃	RDS(on) [mΩ] ※	静電保護DI (GS間)	リリース時期			相当品	
							ES	CS	MP	R社	T社
INK0F14AG1	N	40	60	26	4.2	無し	NOW	‘26/1	‘26/3	–	TPH6R003NL
INK0C1AAG1	N	100	41	13.7	14	無し	‘26/5	‘26/8	‘26/10	–	TPH1400ANH
INK071CAG1	N	200	21.3	6.7	50	有り	NOW	‘26/2	‘26/4	–	TPH6400ENH
INJ0E22AG1	P	30	69.3	22	7	無し	NOW	NOW	‘26/2	RS1E220AT	TPH1R712MD
INJ0B10AG1	P	60	40	-	25	無し	‘26/5	‘26/8	‘26/10	RS1L151AT	–
INJ0B1AAG1	P	100	51.5	11	22	無し	‘26/5	‘26/8	‘26/10	RS1P090AT	–

※VGS=10V時の最大値

© ISAHAYA ELECTRONICS CORPORATION (Ver.4)

※本製品は開発検討中につき、仕様変更となる可能性がございます。